

2SA883

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ／PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅，中速度スイッチング用／

High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching

通信工業用／Industrial Use

2SA883 は，通信工業用モールドトランジスタシリーズ（新シリーズ）の一環として開発されたトランジスタで，特に高信頼度設計がなされており，計測器，端末機器等通信工業用分野に最適です。

特 徴／FEATURES

- ・高周波増幅はもとより，スイッチング，低周波増幅など，広範囲な回路に使用できます。
Suitable for switching and audio amplifier as well as high frequency amplifier.
- ・電源電圧の変動に対して余裕がある。 $V_{CEO} : -40V$
Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
- ・従来の拡散形トランジスタにくらべ，ベース逆バイアスを深くかけることができる。 $V_{EBO} : -8.0V$
Available for deeper base reverse bias than with normal diffused transistors.
- ・直流電流増幅率が高い。 $h_{FE} : 160TYP (I_C = -10mA)$
High DC current gain.

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-8.0	V
コレクタ電流	I_C	-200	mA
全損失	P_T	300	mW
ジャンクション温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ C$

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -40V, I_E = 0$			-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0V, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -10mA$	80	160	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -1.0V, I_C = -100mA$	40	80		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$		-0.2	-0.6	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$		-0.9	-1.2	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	150	280		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		7.5	10	pF
ターンオン時間	t_{on}	測定回路図参照/See test circuit		100		ns
蓄積時間	t_{stg}			200		ns
ターンオフ時間	t_{off}			270		ns

外形図／PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

